【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第４区分
【発行日】平成29年8月31日(2017.8.31)

【公開番号】特開2016-36985(P2016-36985A)
【公開日】平成28年3月22日(2016.3.22)
【年通号数】公開・登録公報2016-017
【出願番号】特願2014-161891(P2014-161891)
【国際特許分類】
Ｂ４１Ｊ　2/14　(2006.01)
Ｂ４１Ｊ　2/16　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｂ４１Ｊ　2/14　６１１
Ｂ４１Ｊ　2/14　２０１
Ｂ４１Ｊ　2/16　１０１
Ｂ４１Ｊ　2/16　５１１

【手続補正書】
【提出日】平成29年7月19日(2017.7.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１】
シリコンウェハに半導体製造工程によって形成され、該形成の後、前記シリコンウェハを切断することにより得られる矩形の素子基板であって、
前記素子基板に実装される回路の検査のために、前記素子基板の外部に設けられた複数の検査用の電極パッドに接続され、前記複数の検査用の電極パッドに印加されるのと同じ電圧が印加される複数の配線を有し、
前記素子基板が前記シリコンウェハから切断される際に、前記複数の配線が切断される複数の切断点は、前記素子基板の端部において、該複数の切断点それぞれに印加される電圧と隣接する切断点に印加される電圧との間の電位差が大きいほど前記隣接する切断点との間の距離が大きくなるように設けられることを特徴とする素子基板。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項２】
前記素子基板に実装される回路を動作させるために電圧を印加する複数のパッドをさらに有することを特徴とする請求項１に記載の素子基板。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
即ち、シリコンウェハに半導体製造工程によって形成され、該形成の後、前記シリコンウェハを切断することにより得られる矩形の素子基板であって、前記素子基板に実装され

る回路の検査のために、前記素子基板の外部に設けられた複数の検査用の電極パッドに接続され、前記複数の検査用の電極パッドに印加されるのと同じ電圧が印加される複数の配線を有し、前記素子基板が前記シリコンウェハから切断される際に、前記複数の配線が切断される複数の切断点は、前記素子基板の端部において、該複数の切断点それぞれに印加される電圧と隣接する切断点に印加される電圧との間の電位差が大きいほど前記隣接する切断点との間の距離が大きくなるように設けられることを特徴とする。